

加工

(後工程装置群)

ダイシングマシン

DISCO社製 DAD3220

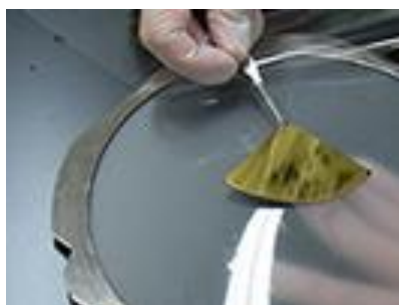
仕様

- 切削方法 ダイヤモンドブレードを用いた切削
- 切削可能範囲 ϕ 6インチ、厚さ1mm程度まで対応可能
- 加工対象 Si、ガラス、半導体パッケージ、セラミックス、石英、水晶等
- 切削精度 $5\mu\text{m}$ 程度
- 切削速度 $0.1\sim 500\text{mm/sec}$

後工程(チップ切断)

Siウェハ等に製作を行った半導体、MEMSデバイスを砥粒を刃状に固めたブレードで切削を行い、ウェハから切断を行います。

一般的な厚さのSiウェハ、ガラス基板、更にSiとガラスの陽極接合等、加工を行った基板を最適なブレードを選定することにより高精度で加工が行えます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX:087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp